

1 / 1

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-022358

(43)Date of publication of application : 24.01.1995

(51)Int.Cl. H01L 21/301  
H01L 21/304

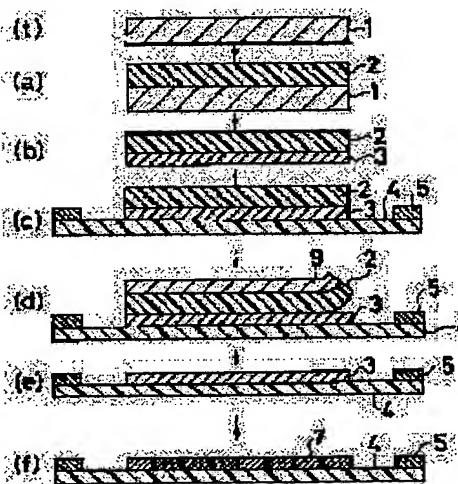
(21)Application number : 05-143393 (71)Applicant : SHARP CORP  
(22)Date of filing : 15.06.1993 (72)Inventor : FUJITA KAZUYA

### (54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

#### (57)Abstract:

**PURPOSE:** To provide a processing method wherein the rear side of an ultra-thin type resin-sealed semiconductor device wafer can be safely polished and diced without causing damage to the wafer.

**CONSTITUTION:** A protecting/reinforcing tape 2 is pasted on the surface of an ultra-thin resin-sealed semiconductor device wafer 1, the rear side of the wafer 1 is polished, the wafer 3 is transferred to a dicing process after polishing, a dicing tape 4 is pasted on the rear side of the wafer 3 keeping the surface protecting-reinforcing tape 2 pasted on the front side of the wafer 1, then the protecting-reinforcing tape 2 is separated off, and then the wafer 3 is diced. A method of separating off the protecting-reinforcing tape 2 pasted on the surface of the wafer 3 is such that the tape 2 is separated off after the wafer 1 is irradiated with ultraviolet rays so as to lessen adhesive agent in adhesive strength or a separating tape 9 whose adhesive power to the protecting.reinforcing tape 2 is larger than that of protecting.reinforcing tape 2 to the front side of the wafer 1 is used to separate off the tape 2.



#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-22358

(43)公開日 平成7年(1995)1月24日

(51)Int.Cl.<sup>a</sup>  
H 01 L 21/301  
21/304

識別記号 施内整理番号  
321 H

F I

技術表示箇所

H 01 L 21/78

M  
P  
Q

審査請求 未請求 請求項の数 6 O L (全 8 頁)

(21)出願番号 特願平5-143393

(22)出願日 平成5年(1993)6月15日

(71)出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72)発明者 藤田 和弥

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ  
ャープ株式会社内

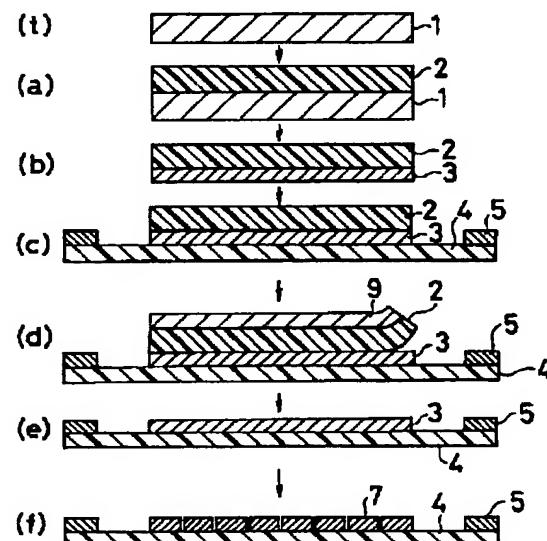
(74)代理人 弁理士 川口 義雄 (外1名)

(54)【発明の名称】 半導体装置の製造方法

(57)【要約】

【目的】 超薄型樹脂封止型半導体装置用ウエハーを、  
ウエハー裏面の研磨からダイシングまでウエハーを破壊  
することなく安全に加工する方法の提供。

【構成】 超薄型樹脂封止型半導体装置用ウエハー1の  
表面に保護・補強用テープ2を貼り付けた状態でウエハー  
1裏面の研磨を行い、研磨完了後にウエハー3をダイ  
シング工程へ搬送し、ウエハー3裏面の研磨後も表面保  
護・補強用テープ2を貼り付けたままでウエハー3裏面  
をダイシング用テープ4に貼り付け、その後、保護・補  
強用テープ2を剥離してダイシングすることにより、ウ  
エハー3の加工を行う。ウエハー3表面の保護・補強用  
テープ2の剥離方法として、紫外線を照射することによ  
り接着剤の接着強度を低下させた後に剥離するか、保護  
・補強用テープ2とウエハー3表面の接着力よりも、保  
護・補強用テープ2との接着力が大きい剥離用テープ9  
を用いて剥離する手段がとられる。



1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウエハーの回路形成面である表面に、保護・補強用テープを貼り付け、上記ウエハーの裏面研磨を行い、上記保護・補強用テープを上記ウエハーの表面に張り付けた状態で、最終ウエハー厚になった上記ウエハーを搬送し、上記ウエハーの裏面をダイシング用テープに貼り付けた後、上記保護・補強用テープを剥離し、ダイシングすることを特徴とする、半導体装置の製造方法。

【請求項2】 最終ウエハー厚が $200\mu\text{m}$ 以下になるまで、上記ウエハーの裏面研磨を行うことを特徴とする、請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項3】 上記保護・補強用テープの接着剤塗布面と反対側の表面に、紫外線を照射することにより、該保護・補強用テープの接着強度を低下させた後、上記保護・補強用テープを剥離することを特徴とする、請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項4】 上記ウエハーの裏面との接着力が上記ウエハーの表面と上記保護・補強用テープとの接着力より大きい上記ダイシング用テープに、上記ウエハーの裏面を張り付け、上記保護・補強用テープの表面との接着力が、上記ウエハーの表面と上記保護・補強用テープとの接着力より大きい剥離用テープを、上記保護・補強用テープの表面に張り付け、上記剥離用テープを剥離することにより、上記保護・補強用テープを剥離することを特徴とする、請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項5】 ウエハーテストを最終ウエハー厚に研磨するまでに行なうことを特徴とする、請求項1記載の半導体装置の製造方法。

【請求項6】 上記ウエハーを上記ダイシング用テープに貼り付け、上記保護・補強用テープを剥離した後、ウエハーテストを行なうことを特徴とする、請求項1記載の半導体装置の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置の製造方法、特に、パッケージ厚が $0.5\text{mm}$ 以下の樹脂封止型半導体装置の製造方法に関するものであり、更に詳しくは、該半導体装置に用いられるウエハーの裏面研磨工程～ダイシング工程に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】現在、図11のメモリーカードにおける、現在の樹脂封止型半導体装置及び本発明を用いて製造された樹脂封止型半導体装置の実装状態図に示すように、メモリーカードの厚さに関しては、規格が決まっている。例えば、現在のメモリーカードに搭載されているパッケージ厚が、 $1.0\text{mm}$ の樹脂封止型半導体装置の場合、JEIDA規格が $3.3\text{mm t}$ では両面実装、また、 $2.2\text{mm t}$ では片面実装が行われている。そして、このパッケージ厚 $1.0\text{mm}$ の樹脂封止型半導体裝

10

20

置に用いられるウエハーは、厚さが $400\mu\text{m}$ 程度のものが用いられている。一方、ウエハー径は、取り数アップを目的として、ますます大口径化され、8インチ径が主流になりつつある。

【0003】以下に、図9及び図10を用いて、従来の厚さ $400\mu\text{m}$ 、8インチ径のウエハーについての、ウエハーの裏面研磨からダイシング工程までを説明する。

【0004】図9は従来のウエハーの裏面研磨からダイシング工程までのプロセスフローチャートであり、図10は同プロセスフローチャートに伴うウエハーの加工状態の断面図である。

【0005】まず、裏面の研磨前のウエハー1の回路形成面である表面の保護を目的として、エチレン酢酸ビニル共重合体（以下、「EVA」とする。）等から成るプラスチックフィルム（以下、「ベースフィルム」とする。）（ $140\mu\text{m}$ ）の片面にアクリル系接着剤（ $10\mu\text{m}$ ）をラミネートした保護用テープ10を研磨前のウエハー1の表面に貼り付け（図9（a）、図10（a））、研磨前のウエハー1の裏面を研磨した後（図9（b）、図10（b））、研磨完了後のウエハー3の表面から保護用テープ10を剥離して（図9（d）、図10（d））、ウエハー3の洗浄を行う（図9（e）、図10（e））。この際、保護用テープ10の剥離方法としては、図10dに示すように、保護用テープ10の接着剤塗布面と反対側の表面との接着力が、保護用テープ10とウエハー3の表面との接着力よりも大きい剥離用テープ9を用いて引き剥がす方法が多く用いられている。

【0006】その後、研磨の終了したウエハー3はプローピングによる電気テスト（以下、「ウエハーテスト」とする。）を行い（図9（t）、図10（t））、アセンブリ工程に投入される。

【0007】アセンブリ工程では、まず、金属のキャリアフレーム5を介して、ウエハー3の裏面をダイシング用テープ4に貼り付ける（図9（c）、図10（c））。その状態でフルカット又はハーフカットにダイシングされ（図9（f）、図10（f））、洗浄・乾燥した後、ダイボンド工程に投入される。ダイボンド工程では、テープ4を介してウエハー3の裏面からピンにより一のチップ7だけ突き上げ、ダイボンドコレットによりダイボンドされる。なお、ハーフカットされたウエハー3はブレイクされた後、ダイボンド工程に投入される。

## 【0008】

【発明が解決しようとする課題】上記規格のメモリーカードの容量アップを、パッケージ厚を薄くすることによって実現しようとする場合、 $1.0\text{mm}$ 厚のパッケージを $0.7\sim0.8\text{mm}$ 厚にしても、JEIDA規格が $3.3\text{mm t}$ においては、3段実装しかできず、また、JEIDA規格が $2.2\text{mm t}$ においては、パッケージ

厚1.0mmの場合と同様に、片面(1段)実装しかでできず、コスト面で問題があり、実用性に乏しい。そこで、JEIDA規格が3.3mm tにおける4段実装、又は、JEIDA規格が2.2mm tにおける2段実装を行い、メモリカードの容量アップを図るために、パッケージ厚は、0.5mm以下となり、0.5mm厚のパッケージに搭載可能な厚さが200μm以下のチップを製造する必要が生じる。

【0009】しかし、上述の製造方法を用いて、現在主流になりつつある8インチ径のウエハーを0.2mm以下の厚さに研磨すると、ウエハー強度が極端に低下するため、その後のウエハーテスト工程、ダイシング用工程における取り扱いや工程間搬送等でウエハーの割れる危険性が非常に高くなるという問題点がある。

【0010】そこで、本発明では、ウエハー裏面の研磨からダイシングまでの間で、ウエハーを破壊することなく加工でき、パッケージ厚が0.5mm以下の樹脂封止型半導体装置の製造工程の歩留りを向上させる手段を提供することを目的とする。

#### 【0011】

【課題を解決するための手段】本発明では、上記課題を解決するため、樹脂封止型半導体装置を製造するに当たり、ウエハーの回路形成面である表面に、保護・補強用テープを貼り付け、上記ウエハーの裏面研磨を行い、上記保護・補強用テープを上記ウエハーの表面に張り付けた状態で、最終ウエハー厚になった上記ウエハーを搬送し、上記ウエハーの裏面をダイシング用テープに貼り付けた後、上記保護・補強用テープを剥離し、ダイシングすることを特徴としている。

【0012】上記ウエハーの裏面研磨は、最終ウエハー厚が200μm以下になるまで行われる。

【0013】上記保護・補強用テープを剥離するには、上記保護・補強用テープの接着剤塗布面と反対側の表面に、紫外線を照射することにより、該保護・補強用テープの接着強度を低下させた後に剥離するという手段がとられる。

【0014】更に、上記ウエハーの裏面との接着力が上記ウエハーの表面と上記保護・補強用テープとの接着力より大きい上記ダイシング用テープに、上記ウエハーの裏面を張り付け、上記保護・補強用テープの表面との接着力が、上記ウエハーの表面と上記保護・補強用テープとの接着力より大きい剥離用テープを、上記保護・補強用テープの表面に張り付け、上記剥離用テープを剥離することにより、上記保護・補強用テープを剥離することを特徴としている。

【0015】更に、ウエハーテストは、最終ウエハー厚に研磨するまでに行う。又は、上記ウエハーをダイシング用テープに貼り付け、上記保護・補強用テープを剥離した後に行うという工程がとられる。

#### 【0016】

【作用】本発明では、ウエハー裏面の研磨完了後に、最終ウエハー厚(200μm以下)のウエハー表面に保護・補強用テープを貼り付けたままでダイシング工程へ搬送し、このウエハー裏面にダイシング用テープを貼り付けた後、剥離用テープを用いて保護・補強用テープを剥離して、ダイシングにより1チップづつに切り分けられる。この結果、ウエハー研磨後はチップ状にダイシングされるまで、保護・補強用テープまたはダイシング用テープのいずれかによってウエハーが補強されているので、ウエハーハンドリングや搬送中にウエハーが破損する危険性が大幅に低減される。

【0017】さらに、従来ウエハー研磨後に実施していたウエハーテストを、(1)最終ウエハー厚(200μm以下)まで研磨する前に、又は(2)ウエハー裏面の研磨完了後ダイシング用テープに貼り付け、その後保護・補強用テープを剥離した状態で実施することにより、ウエハーテスト工程でのウエハー破損を防止することができる。

【0018】また、紫外線を照射することにより、ウエハーとダイシング用テープの接着力を維持したまま保護・補強用テープ剥離ができる。

#### 【0019】

【実施例】本発明による4実施例を下記に示す。

#### 【0020】実施例1

図1及び図2に、ウエハーの加工工程のプロセスフローチャートとそれに伴うウエハーの加工状態を示す。

【0021】(t)所定の金属配線・パッシベーション膜形成工程が完了し、裏面の研磨前の8インチ径ウエハー1(ウエハー厚:725μm)の状態でウエハーテストを実施する。

【0022】(a)裏面研磨前にウエハー1(以下、「ウエハー1」とする。)表面に保護・補強用テープ2を貼り付ける。保護・補強用テープ2は例えば、ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム(500μm厚)にアクリル系保護・補強用テープ接着剤(10μm)をラミネートしたものであり、40℃程度に加熱した状態でウエハー1表面に貼り付ける。

【0023】(b)ウエハー1裏面を約525μm研磨し(ウエハー厚:200μm)、研磨完了後に、最終ウエハー厚(200μm)のウエハー3(以下、「ウエハー3」とする。)表面に保護・補強用テープ2を貼り付けたままでウエハー3をダイシング工程へ搬送し、

(c)保護・補強用テープ2を貼り付けた状態のウエハー3裏面を金属キャリアフレーム5を介してダイシング用テープ4に貼り付ける。ダイシング用テープ4は、例えば、塩化ビニルフィルムに接着剤をラミネートしたものであり、テープ厚は80μmである。

【0024】(d)図2に示すように、保護・補強用テープ2を、保護・補強用テープ2裏面とウエハー3表面の接着力よりも保護・補強用テープ2表面との接着力が

5

大きい剥離用テープ9を用いて引きはがす。この時、ウエハー3裏面を真空吸着により固定しておく。剥離用テープ9は、ベースフィルムにPETを用い、これにアクリル系接着剤より接着力が大きい天然ゴム系接着剤をラミネートしたものを使用する。

【0025】(e) 純水による超音波洗浄によりウエハー3表面の接着剤の残りを洗い落とす。

【0026】(f) ダイヤモンドホイールを用いてウエハー3をダイシングし、所定のサイズのチップ7を形成する。

【0027】(g) ダイボンド工程に移る。

【0028】本発明に用いるウエハー3表面の保護・補強用テープ2の目的は、① 研磨時のウエハー表面保護と、② 研磨後からウエハー3裏面をダイシング用テープ4に貼り付けるまでのウエハー3の補強である。

【0029】従来は、上記①だけの目的で保護用テープを用いていたが、本発明のウエハー補強効果を最大限に引き出すにはベースフィルムの合成を高める必要がある。フィルムの合成は、弾性率と厚みが大きくなるほど高くなるので、ウエハー裏面研磨厚精度、テープ剥離性に影響を及ぼさない範囲で弾性率を高く、厚膜化することが望ましい。

【0030】そこで、本発明では、従来の140μm厚さのEVA(弾性率350kg/cm<sup>2</sup>)の代わりに、例えば、500μm厚さのPET(ポリエチレンテレフタレート弾性率1,000kg/cm<sup>2</sup>)をベースフィルムとして用いることにより、補強効果をより高めることができる。接着剤については、従来と同様なもので対応できる。

【0031】次に、本発明では、ウエハー3裏面をダイシング用テープ4に接着した状態で、ウエハー3表面に添付した保護・補強用テープ2を剥離するが、この場合、ウエハー3裏面をダイシング用テープ4を介して真空吸着固定し、保護・補強用テープ2裏面とウエハー3表面の接着力よりも、保護・補強用テープ2表面との接着力が大きい剥離用テープ9を用いて引き剥がす。この時点での各テープの接着力は、次の関係を有していないわけではない。

【0032】[剥離用テープ9と保護・補強用テープ2表面の接着力] > [保護・補強用テープ2裏面とウエハー3表面の接着力]

[ウエハー3裏面とダイシング用テープ4の接着力] > [保護・補強用テープ2裏面とウエハー3表面の接着力]

例えば、シリコンウエハーとのピール接着力(20mm長さの剥離に必要な力)において、

[剥離用テープ9と保護・補強用テープ2表面の接着力]が 2000g

[保護・補強用テープ2裏面とウエハー3表面の接着力]が 75g

10

6

[ウエハー3裏面とダイシング用テープ4の接着力]が 100g の関係にあるテープを用いることで、本発明の実施が可能である。

#### 【0033】実施例2

この実施例は実施例1に対してウエハー3表面の保護・補強用テープ2の剥離工程において紫外線照射による接着剤硬化により接着性を低下させ、剥離時にウエハー3に与えるストレスを低下させる方法について説明する。

【0034】図3及び図4にウエハーの加工工程のプロセスフローチャートとそれに伴うウエハーの加工状態を示す。

【0035】(t) 裏面の研磨前の8インチ径ウエハー1(ウエハー厚: 725μm)の状態でウエハーテストを実施する。

【0036】(a) 裏面の研磨前のウエハー1表面に、保護・補強用テープ2を貼り付ける。この場合の保護・補強用テープ2の接着剤は、紫外線照射により硬化反応が起り接着性が低下するタイプ、例えば、アクリル系接着剤(UV反応架橋剤)である。

【0037】(b) ウエハー1裏面を約525μm研磨し(ウエハー厚: 200μm)、研磨完了後に、最終ウエハー厚(200μm)のウエハー3表面に保護・補強用テープ2を貼り付けたままでウエハー3をダイシング工程へ搬送し、

(c) 保護・補強用テープ2を貼り付けた状態の研磨後のウエハー3裏面を金属キャリアフレーム5を介してダイシング用テープ4に貼り付ける。

【0038】(d) ウエハー3表面側から強度200~300mJ/cm<sup>2</sup>の紫外線を2~3sec照射して接着力を低下させる。その後、剥離用テープ9を用いて引きはがす。

【0039】(e) 純水による超音波洗浄によりウエハー3表面の接着剤の残りを洗い落とす。

【0040】(f) ダイヤモンドホイールを用いてウエハー3をダイシングし、所定のサイズのチップ7を形成する。

【0041】(g) ダイボンド工程に移る。

#### 【0042】実施例3

この実施例は最終ウエハー厚(この場合、200μm厚)まで研磨する前にウエハーテストを実施する場合の製造方法について説明する。これはウエハーテスト時にウエハーのバルク電位を測定回路に組み込む必要がある場合に用いる製造方法に関する。

【0043】また、ウエハー3表面の保護・補強用テープ2剥離後の純水洗浄をダイシング後の洗浄工程で兼用する方法について説明する。

【0044】図5及び図6にウエハーの加工工程のプロセスフローチャートとそれに伴うウエハーの加工状態を示す。

50

7

【0045】(a) 8インチ径ウエハー1(ウエハー厚: 725μm)の表面に、実施例1と同じ保護・補強用テープ2を貼り付ける。

【0046】(b) ウエハー1裏面を約50μm研磨する(ウエハー厚: 675μm)。

【0047】(d) 実施例1と同じ剥離用テープ9を用いて、675μm厚の一次研磨後のウエハー8(以下「ウエハー8」とする。)から保護・補強用テープ2を剥離する。

【0048】(e) 純水超音波洗浄を行う。

【0049】(t) ウエハーテストを行う。

【0050】(a) 再度、ウエハー8に保護・補強用テープ2を貼り付ける。

【0051】(b) ウエハー8裏面を約475μm研磨し(ウエハー厚: 200μm)、研磨完了後に、最終ウエハー厚(200μm)のウエハー3表面に保護・補強用テープ2を貼り付けたままでウエハー3をダイシング工程へ搬送し、

(c) 保護・補強用テープ2を貼り付けた状態の研磨後のウエハー3裏面を金属キャリアフレーム5を介してダイシング用テープ4に貼り付ける。

【0052】(d) 実施例1と同じ剥離用テープ9を用いて保護・補強用テープ2を引きはがす。

【0053】(f) ダイヤモンドホイールを用いてウエハー3をダイシングし、所定のサイズのチップ7を形成し、その後の純水洗浄でダイシングのシリコン切屑と一緒にウエハー3表面の保護・補強用テープ2の接着剤残渣を除去する。

【0054】(g) ダイボンド工程に移る。

【0055】実施例4

この実施例はウエハーテストをウエハー裏面の研磨完了後ダイシング用テープ4に貼付し、保護・補強用テープ2を剥離した状態で実施する製造方法について説明する。

【0056】この方法は最終ウエハー厚まで研磨した状態でウエハーテストできるのでウエハー3に加わるストレス等を考慮するとフローチャート上では最も好ましいと言える。

【0057】図7及び図8にウエハーの加工工程のプロセスフローチャートとそれに伴うウエハーの加工状態を示す。

【0058】(a) 裏面の研磨前の8インチ径ウエハー1(ウエハー厚: 725μm)表面に、実施例1と同じ保護・補強用テープ2を貼り付ける。

【0059】(b) ウエハー1裏面を約525μm研磨し(ウエハー厚: 200μm)、研磨完了後に、最終ウエハー厚(200μm)のウエハー3表面に保護・補強用テープ2を貼り付けたままでウエハー3をダイシング工程へ搬送し、

(c) 保護・補強用テープ2を貼り付けた状態でウエハ

10

ー3裏面を金属キャリアフレーム5を介してダイシング用テープ4に貼り付ける。

【0060】(d) 実施例1と同じ剥離用テープ9を用いて保護・補強用テープ2を引きはがす。

【0061】(e) 純水による超音波洗浄によりウエハー3表面の接着剤の残りを洗い落とす。

【0062】(t) ウエハーテストを実施する。

【0063】(f) ダイヤモンドホイールを用いてウエハー3をダイシングし、所定のサイズのチップ7を形成する。

【0064】(g) ダイボンド工程に移る。

【0065】

【発明の効果】以上説明したように、本発明はウエハー裏面の研磨完了後、最終ウエハー厚(200μm)のウエハー表面に保護・補強用テープを貼り付けたままで次工程であるダイシング工程へ搬送し、このウエハー裏面にダイシング用テープを貼り付けた後、剥離用テープを用いて保護・補強用テープを剥離して、ダイシングされる。この結果、ウエハー研磨後もウエハーはいつも保護・補強用テープ又はダイシング用テープのいずれかによって補強されているので、ウエハーハンドリングや搬送中にウエハーの割れることがない安定した製造方法を得ることができる。

【0066】さらに加えて、従来ウエハー研磨後に実施していたウエハーテストを、(1) 最終ウエハー厚(200μm)まで研磨する前に、又は(2) ウエハー裏面の研磨完了後ダイシング用テープに貼り付け、その後、保護・補強用テープを剥離した状態で実施するため、ウエハーテスト工程でのウエハー破損も防止ができる。

【0067】以上のことにより、パッケージ厚0.5mm以下の半導体装置の製造工程の歩留りを向上させることできる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例1のウエハー裏面の研磨からダイシング工程までのプロセスフローチャートである。

【図2】本発明の実施例1のウエハー裏面の研磨からダイシング工程に伴うウエハーの加工状態の断面図である。

【図3】本発明の実施例2のウエハー裏面の研磨からダイシング工程までのプロセスフローチャートである。

【図4】本発明の実施例2のウエハー裏面の研磨からダイシング工程に伴うウエハーの加工状態の断面図である。

【図5】本発明の実施例3のウエハー裏面の研磨からダイシング工程までのプロセスフローチャートである。

【図6】本発明の実施例3のウエハー裏面の研磨からダイシング工程に伴うウエハーの加工状態の断面図である。

【図7】本発明の実施例4のウエハー裏面の研磨からダ

20

20

30

30

40

40

50

9

イシング工程までのプロセスフローチャートである。  
【図8】本発明の実施例4のウエハー裏面の研磨からダイシング工程に伴うウエハーの加工状態の断面図である。

【図9】従来のウエハー裏面の研磨からダイシング工程までのプロセスフローチャートである。

【図10】従来のウエハー裏面の研磨からダイシング工程までのプロセスフローチャートに伴うウエハーの加工状態の断面図である。

【図11】パッケージの薄型化と高密度化の関係の説明 10

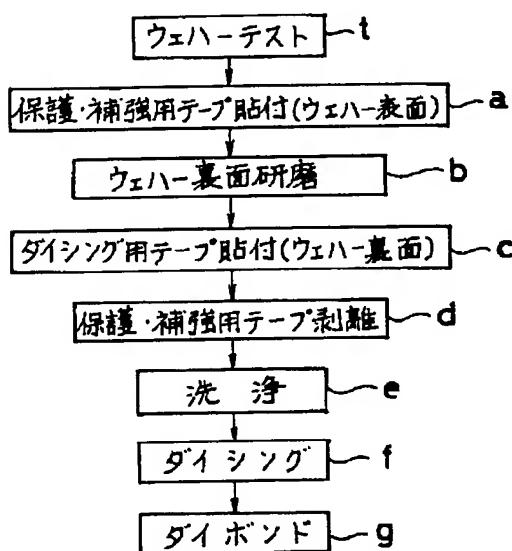
10

図である。

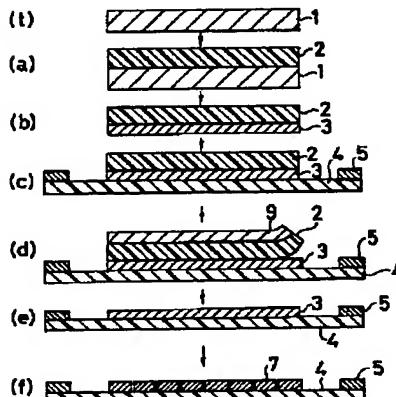
## 【符号の説明】

- 1 研磨前のウエハー
- 2 保護・補強用テープ
- 3 最終厚まで研磨後のウエハー
- 4 ダイシング用テープ
- 5 金属製キャリアフレーム
- 7 チップ
- 8 1次研磨後のウエハー
- 9 剥離用テープ

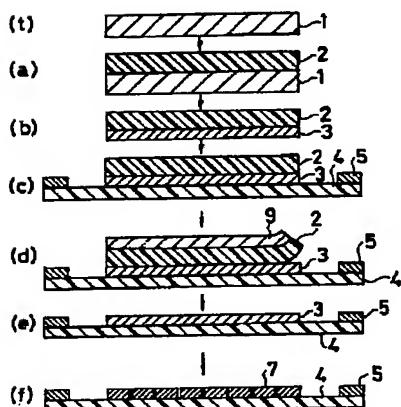
【図1】



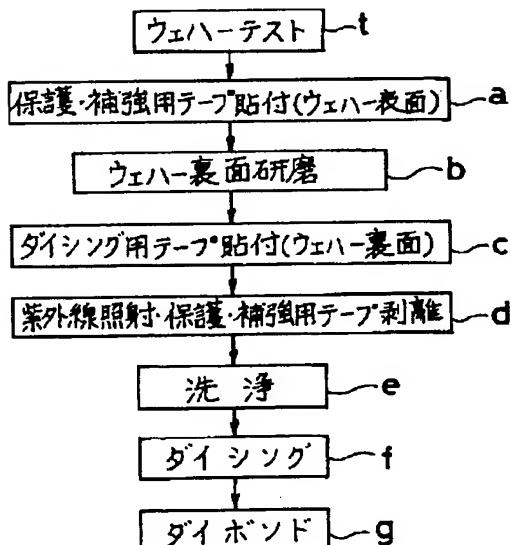
【図2】



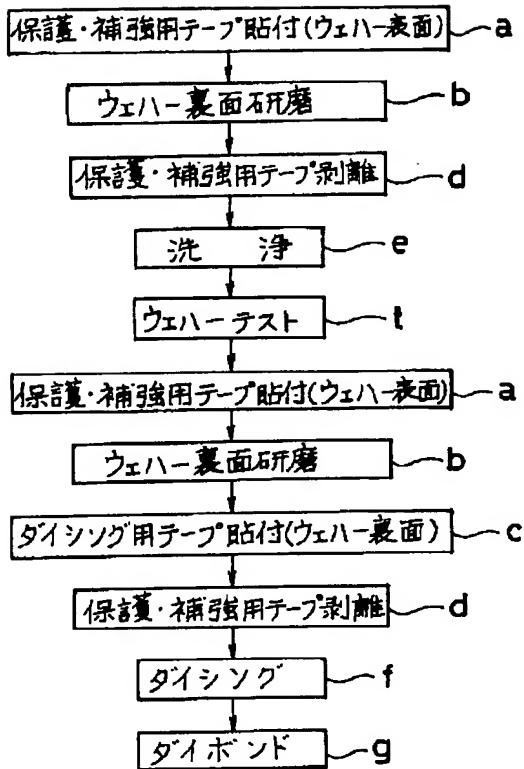
【図4】



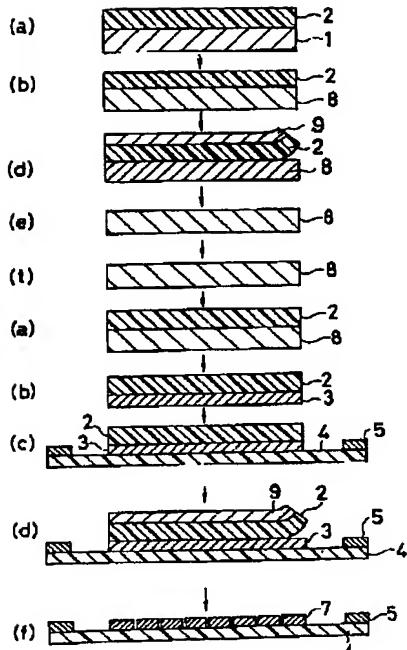
【図3】



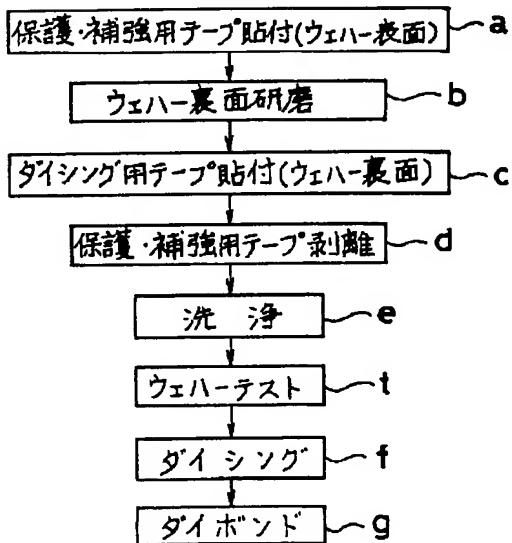
【図5】



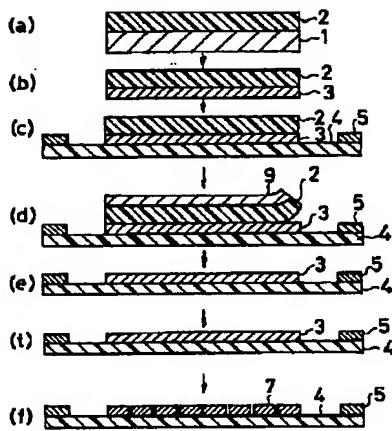
【図6】



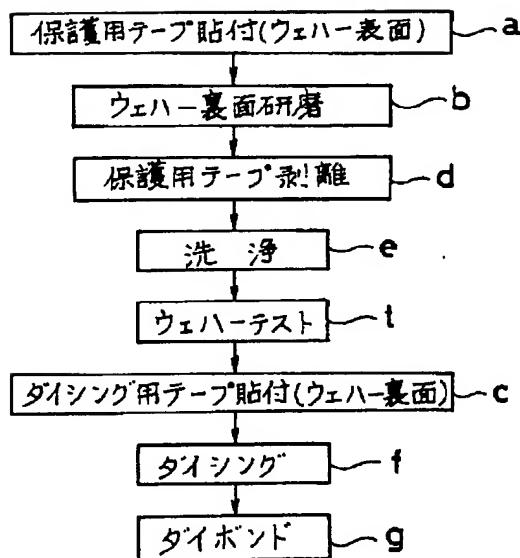
【図7】



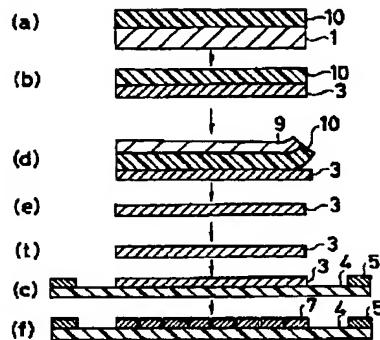
【図8】



【図9】



【図10】



【図11】

PKG厚 メモリカード厚	TSOP搭載(現状) 1.0mm	スーパーTSOP搭載 0.45mm
JEIDA 3.3mm	TSOP 両面実装	スーパーTSOP 4段実装 メモリ容量UP 薄型化
JEIDA 2.2mm	片面実装	メモリ容量UP 両面実装